



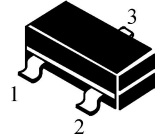
安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

MMBTA94

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ FEATURES 特點

■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Rating 額定值 | Unit 單位 |
|--|----------------|------------|---------|
| Collector-Emitter Voltage 集電極-射極電壓 | V_{CEO} | -400 | V |
| Collector-Base Voltage 集電極-極電壓 | V_{CBO} | -400 | V |
| Emitter-Base Voltage 發射極基極電壓 | V_{EBO} | -7 | V |
| Collector Current 集電極電流 | I_c | -200 | mA |
| Device Dissipation 耗散功率 | P_D | 225 | mW |
| Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度 | T_J, T_{stg} | -55to+125 | °C |

■ DEVICE MARKING 打標

MMBTA94=4D



MMBTA94

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

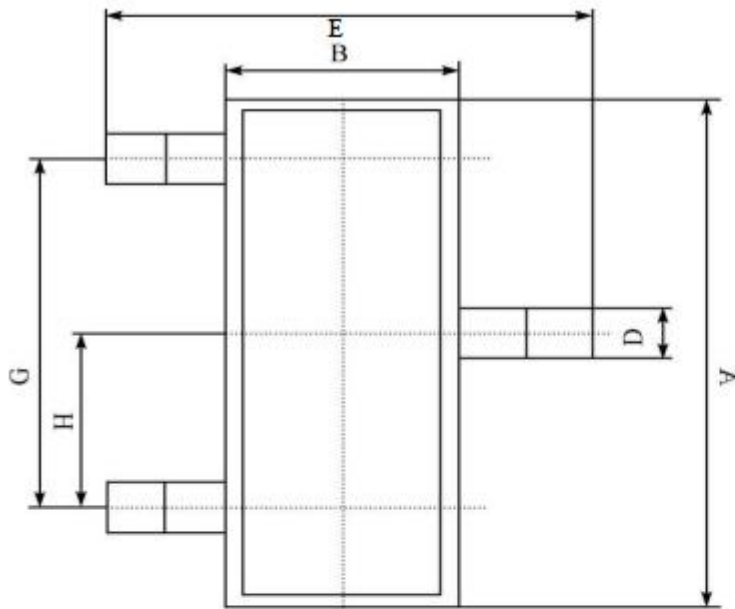
($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Min 最小值 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|--|---------------|---------|---------|---------|
| Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-射極擊穿電壓($I_C=-1\text{mA}, I_B=0$) | $V_{(BR)CEO}$ | -400 | — | V |
| Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓($I_C=-100\mu\text{A}, I_E=0$) | $V_{(BR)CBO}$ | -400 | — | V |
| Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓($I_E=-100\mu\text{A}, I_C=0$) | $V_{(BR)EBO}$ | -7 | — | V |
| Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ($V_{CB}=-400\text{V}, I_E=0$) | I_{CBO} | — | -500 | nA |
| DC Current Gain 直流電流增益 ($I_C=-10\text{mA}, V_{CE}=-10.0\text{V}$) | H_{FE} | 40 | 240 | — |
| Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降 ($I_C=-20\text{mA}, I_B=-2\text{mA}$) | $V_{CE(sat)}$ | — | -0.6 | V |
| Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益帶寬乘積 ($I_C=-10\text{mA}, V_{CE}=-20\text{V}, f=30\text{MHz}$) | f_T | 50 | — | MHz |

MMBTA94

■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



| 代碼 | 範圍(單位:mm) |
|----|-----------|
| A | 2.80~3.00 |
| B | 1.20~1.40 |
| C | 0.90~1.10 |
| D | 0.30~0.50 |
| E | 2.20~2.60 |
| G | 1.80~2.00 |
| H | 0.90~1.00 |
| J | 0.08~0.18 |
| K | 0.02~0.12 |
| M | ≥0.22 |
| N | 0.50~0.70 |
| P | 6°~10° |

